



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HX128M**

对应国外型号  
STC128M

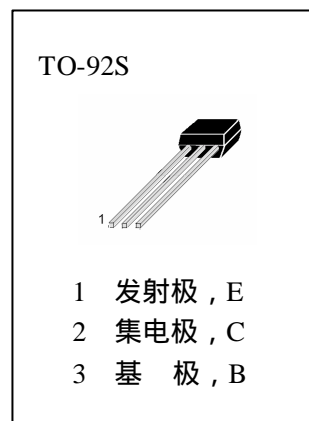
### 主要用途

低压大电流驱动。

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$	——贮存温度.....	-55~150
$T_j$	——结温.....	150
$P_C$	——集电极耗散功率.....	400mW
$V_{CBO}$	——集电极—基极电压.....	20V
$V_{CEO}$	——集电极—发射极电压.....	15V
$V_{EBO}$	——发射极—基极电压.....	6.5V
$I_C$	——集电极电流.....	1.5A

### 外形图及引脚排列



### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	20			V	$I_C=50\mu A, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	15			V	$I_C=1mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	6.5			V	$I_E=50\mu A, I_C=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			0.1	$\mu A$	$V_{CB}=20V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			0.1	$\mu A$	$V_{EB}=6V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	150				$V_{CE}=1V, I_C=100mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.3	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
$f_T$	特征频率		260		MHz	$V_{CE}=5V, I_C=50mA$
$C_{ob}$	共基极输出电容		5		pF	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$
$R_{on}$	通态电阻		0.6			$f=1KHz, I_B=1mA, V_{IN}=0.3V$